3P124 Si と C の ¹D^o と ³D^o の電子状態について

(名市大システム自然科学1中京大学2) 森山浩子1 山本茂義2 舘脇洋1

[初めに]

前回は Si について[19s19p16d6f5g]の Gauss 型関数(GTF)を用い、³D^o状態について 3s¹3p³ と 3s²3p¹nd¹ からの1、2電子励起をすべて考慮した Cl(MRSDCl)計算を行ないその電子状 態を報告した。今回は高い Rydberg 状態をさらにくわしく調べることを目的とし、d 型関数 を 16 個から 21 個にふやして Si の(3pnd) ¹D^oと ³D^o状態の計算を行なった。C の(2pnd) ¹D^o と ³D^o状態についても同様の計算を行なったが、ここでは紙面の関係で Si の電子状態のみに ついて説明を行なう。

[基底関数]

(1)3s²3p¹ イオン殻の 1s2s2p3s3p 軌道用 cGTF 基底: uncontracted GTF 16s11p (Koga, Tatewaki, & Shimazaki, Chem.Phys.Lett. 2000,328, 473) を用い、3s²3p¹に対して解いた SCF 軌道そのものをイオン核の基底として使用。

(2)spRydberg 用 primitiveGTF(pGTF) 基底: 16 個の s 型 pGTF、17 個の p 型 pGTF を使用。
(3)nd Rydberg 用 pGTF 基底: 6 項展開した 3d GTF の内側 4 項目の GTF の指数因子と、水素原子の 13d と同じ平均距離<r>を与える GTF の指数因子 0.000108 との間を 1.5 で補間し、合計 21 個の d 型 pGTF 基底を使用。

(4)fg correlating 用 pGTF 基底: 6 個の f 型 pGTF 、5 個の g 型 pGTF を使用。

この結果、使用した基底関数は[19s19p21d6f5g]である。

[計算方法]

1.上記の基底関数を用いて、プログラム ATOMCI を使用し、次の計算を行なった。

(1) 3s²3p¹nd¹ (n=3~23)空間での対角化(21 次元 CI)。

(2) (1)で対角化された 3s²3p¹nd¹空間に 3s¹3p³を加えた 22 次元空間での対角化(22 次元 Cl)。
 (3)MRSDCI 計算。

d 軌道には(3pnd)を対角化した計算(1)による d 軌道を用い、1~3s、2,3p 軌道には 3s²3p¹ イオンの SCF 軌道を、他はイオンの MRSDCI 計算による natural orbital を用いた。参 照関数は、3s²3p¹nd¹(n=3~23)+3s¹3p³+3s¹3p²4p¹である。

2. (3)の計算で得られたエネルギーを非摂動項とし、spin-orbit interaction を摂動として考えたJ値ごとの小さなCI計算

[結果] 表 1 に Si の ${}^{1}D^{\circ}, {}^{3}D^{\circ}$ 状態について ATOMCI を使用した 22 次元 CI と MRSDCI の計 算による励起エネルギー値を与える。MRSDCI による計算値と実験値との対応は概ね良い。

			1				
 ¹ D ^o	22 次元 CI	MRSDCI	実験値	³ D°	22 次元 CI	MRSDCI	実験値
State7	7.462	7.900	7.947	State7	7.486	7.877	7.945
State6	7.408	7.844	7.899	State6	7.442	7.810	7.879
State5	7.328	7.760	7.818	State5	7.283	7.708	7.778
State4	7.201	7.627	7.688	State4	7.126	7.540	7.609
State3	6.980	7.393	7.458	State3	6.843	7.237	7.306
State2	6.550	6.929	6.987	State2	6.269	6.628	6.705
State1	5.571	5.767	5.852	State1	5.122	5.442	5.598

表 1 Si(3pnd) ¹D^oと(3pnd) ³D^oの励起エネルギー値(eV)

表 2 には 22 次元 CI と MRSDCI による 3s¹3p³と主たる 3s²3p¹nd¹の重み、及びその他の 3s²3p¹nd¹の重みの合計(Σ'3s²3p¹nd¹)を与える。

¹ Dº 主 3s²3p1nd1		Σ '3s²3p¹nd¹	3s¹3p³	³ Dº 主 3s ² 3p1nd1		Σ '3s ² 3p ¹ nd ¹	3s¹3p³
22 次元 CI			2	2 次元 CI			
State7	0.873	0.125	0.002	State7	0.856	0.140	0.004
State6	0.873	0.124	0.003	State6	0.852	0.142	0.006
State5	0.874	0.122	0.004	State5	0.846	0.144	0.010
State4	0.874	0.120	0.007	State4	0.833	0.149	0.018
State3	0.873	0.115	0.012	State3	0.803	0.158	0.039
State2	0.875	0.102	0.024	State2	0.693	0.190	0.117
State1	0.893	0.050	0.057	State1	0.264	0.189	0.547
MRSDCI				MRSDCI			
State7	0.685	0.247	0.003	State7	0.915	0.016	0.004
State6	0.687	0.243	0.004	State6	0.911	0.017	0.006
State5	0.689	0.232	0.007	State5	0.904	0.020	0.010
State4	0.692	0.232	0.010	State4	0.888	0.026	0.018
State3	0.696	0.220	0.017	State3	0.848	0.040	0.043
State2	0.701	0.200	0.031	State2	0.702	0.088	0.136
State1	0.747	0.100	0.076	State1	0.221	0.170	0.531

表 2 Si(3pnd) ¹D^o と(3pnd) ³D^o の重要な電子配置

表 2 からわかる通り、 $3s^23p^1nd^1$ (n=3~23)で対角化した nd 軌道を用い、 $3s^13p^3$ を加えた 22 次元空間で再対角化を行うと、 $3s^13p^3$ と $3s^23p^1nd^1$ との相互作用により、対角化されてい た $3s^23p^1nd^1$ 間の再混合が起こり、 $3s^13p^3$ が perturber として働いていることが確かめられる。 この計算では、 $^1D^o$ と $^3D^o$ 状態とで State3 以降における perturber の働きに大きな差はない。 ところが MRSDCI 計算を行なうと、従来の研究で $3s^13p^3$ と $3s^23p^1nd^1$ の混じりが大きいと されていた Si の $^3D^o$ 状態で再混合が小さくなり、純粋な Rydberg 状態であるとみなされて いた $^1D^o$ 状態で Rydberg 状態の再配列が大きくなることがわかる。すなわち $^1D^o$ 状態も perturbed Rydberg series を構成する。量子欠損、ならびに spin-orbit interaction、炭素原子 の結果については当日発表する。